

双 N 沟道 MOSFET

ELM16800EA-S

<http://www.elm-tech.com>

■概要

ELM16800EA-S 是 N 沟道低输入电容、低工作电压、低导通电阻的大电流 MOSFET，内藏有两个 MOSFET。

■特点

- $V_{ds}=30V$
- $I_d=3.4A$ ($V_{gs}=10V$)
- $R_{ds(on)} < 60m\Omega$ ($V_{gs}=10V$)
- $R_{ds(on)} < 75m\Omega$ ($V_{gs}=4.5V$)
- $R_{ds(on)} < 115m\Omega$ ($V_{gs}=2.5V$)

■绝对最大额定值

如没有特别注明时, $T_a=25^\circ C$

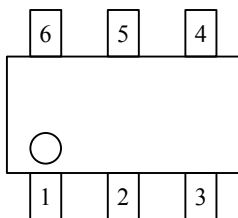
项目	记号	规格范围	单位	备注	
漏极 - 源极电压	V_{ds}	30	V		
栅极 - 源极电压	V_{gs}	± 12	V		
漏极电流 (定常)	Id	$T_a=25^\circ C$	3.4	A	1
		$T_a=70^\circ C$	2.7		
漏极电流 (脉冲)	I_{dm}	20	A	2	
容许功耗	Pd	$T_c=25^\circ C$	1.15	W	
		$T_c=70^\circ C$	0.73		
结合部温度及保存温度范围	T_j, T_{stg}	-55 ~ 150	$^\circ C$		

■热特性

项目	记号	典型值	最大值	单位	备注
最大结合部 - 环境热阻	$R_{\theta ja}$	78	110	$^\circ C/W$	1
最大结合部 - 环境热阻		稳定状态	106	150	
最大结合部 - 引脚架热阻	$R_{\theta jl}$	64	80	$^\circ C/W$	3

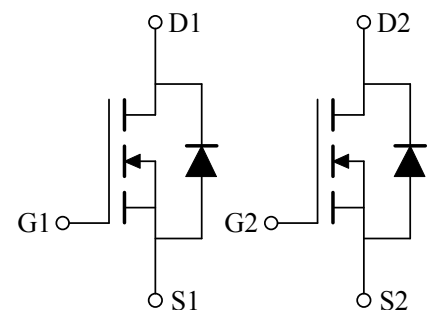
■引脚配置图

SOT-26(俯视图)



引脚编号	引脚名称
1	GATE1
2	SOURCE2
3	GATE2
4	DRAIN2
5	SOURCE1
6	DRAIN1

■电路图



双 N 沟道 MOSFET

ELM16800EA-S

<http://www.elm-tech.com>

■电特性

如没有特别注明时, Ta=25℃

项目	记号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
静态特性						
漏极 - 源极击穿电压	BVdss	Id=250μA, Vgs=0V	30			V
栅极接地时漏极电流	Idss	Vds=24V, Vgs=0V Ta=55℃			1	μA
					5	
栅极漏电流	Igss	Vds=0V, Vgs=±12V			100	nA
栅极阈值电压	Vgs(th)	Vds=Vgs, Id=250μA	0.6	1.0	1.4	V
导通时漏极电流	Id(on)	Vgs=4.5V, Vds=5V	20			A
漏极 - 源极导通电阻	Rds(on)	Vgs=10V, Id=3.4A Ta=125℃		50	60	mΩ
				66	80	
		Vgs=4.5V, Id=3A		60	75	
			Vgs=2.5V, Id=2A		88	
正向跨导	Gfs	Vds=5V, Id=3A		7.8		S
二极管正向压降	Vsd	Is=1A, Vgs=0V		0.8	1.0	V
寄生二极管最大连续电流	Is				1.5	A
动态特性						
输入电容	Ciss			390.0		pF
输出电容	Coss	Vgs=0V, Vds=15V, f=1MHz		54.5		pF
反馈电容	Crss			41.0		pF
栅极电阻	Rg	Vgs=0V, Vds=0V, f=1MHz		3		Ω
开关特性						
总栅极电荷	Qg			4.96		nC
栅极 - 源极电荷	Qgs	Vgs=4.5V, Vds=15V, Id=3.4A		0.80		nC
栅极 - 漏极电荷	Qgd			1.72		nC
导通延迟时间	td(on)			6.8		ns
导通上升时间	tr	Vgs=10V, Vds=15V		3.6		ns
关闭延迟时间	td(off)	RL=4.7Ω, Rgen=6Ω		35.2		ns
关闭下降时间	tf			13.7		ns
寄生二极管反向恢复时间	trr	If=3.4A, dIf/dt=100A/μs		11.4		ns
寄生二极管反向恢复电荷	Qrr	If=3.4A, dIf/dt=100A/μs		6.0		nC

备注:

1. Rθja 值是在 Ta=25℃、使用设置于 2 盎司 FR-4 覆铜板上的装置测试所得到的结果。此外, 实际阻值还受到电路板设计的影响, 并且电流定格依存于 t ≤ 10s 时的热阻定格值。
2. 重复速率和脉冲宽度受结合部温度的控制。
3. Rθja 是结合部 - 引脚架热阻和结合部 - 环境热阻的和。
4. 标准特性图 1 ~ 6 是在脉冲为 80μs, 最大占空比为 0.5% 的条件下得到的。
5. 参数是在 Ta=25℃, 将 IC 设置于 2 盎司 FR-4 覆铜板的测试结果。SOA 曲线决定脉冲的定格。

双 N 沟道 MOSFET

ELM16800EA-S

<http://www.elm-tech.com>

■ 标准特性和热特性曲线

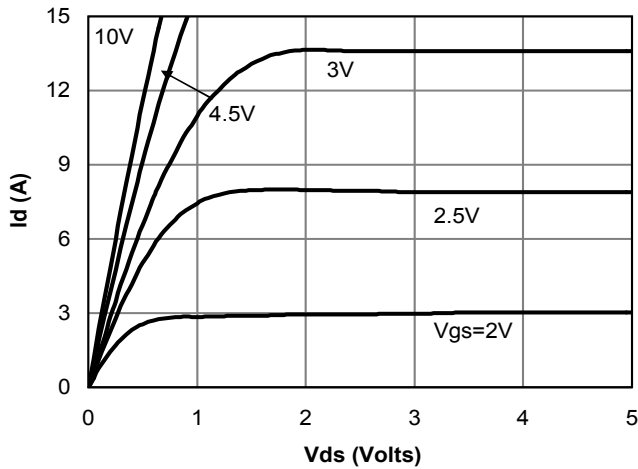


Fig 1: On-Region Characteristics

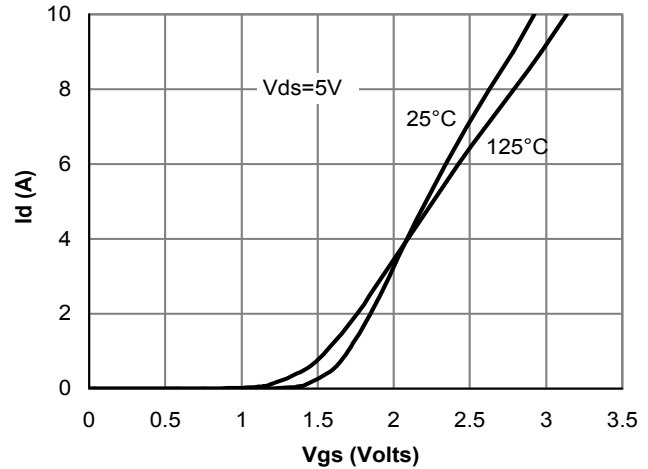


Figure 2: Transfer Characteristics

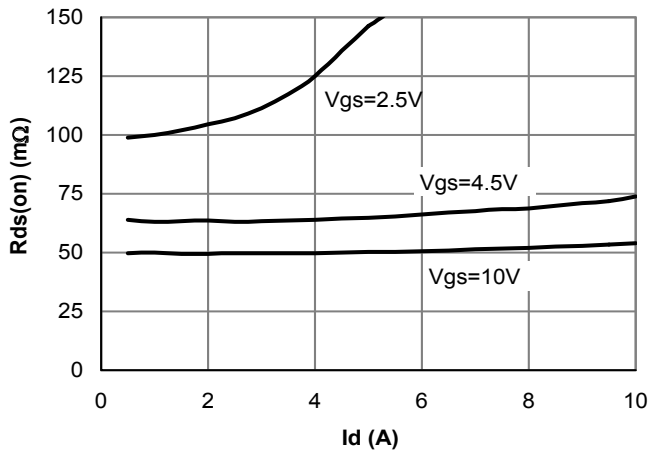


Figure 3: On-Resistance vs. Drain Current and Gate Voltage

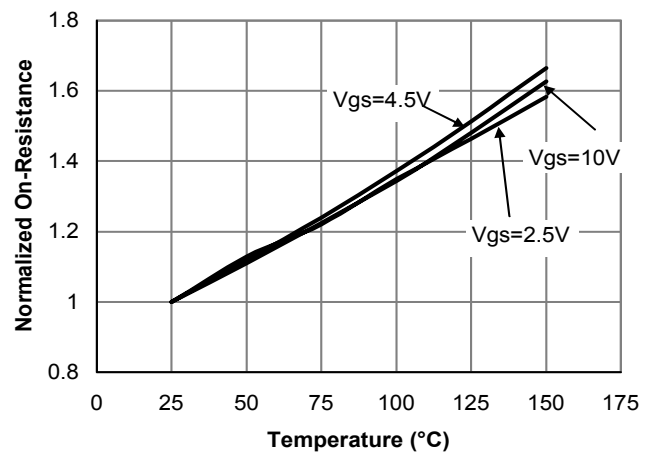


Figure 4: On-Resistance vs. Junction Temperature

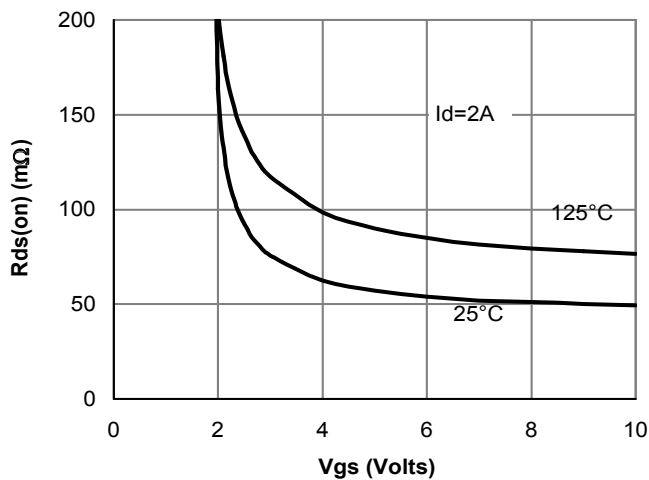


Figure 5: On-Resistance vs. Gate-Source Voltage

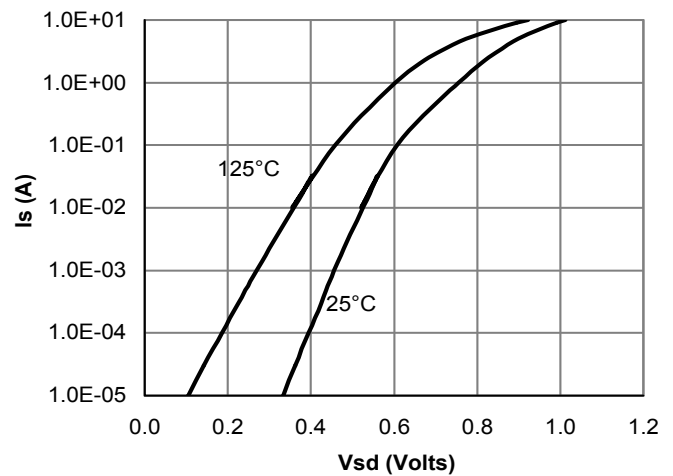


Figure 6: Body-Diode Characteristics

双 N 沟道 MOSFET

ELM16800EA-S

<http://www.elm-tech.com>

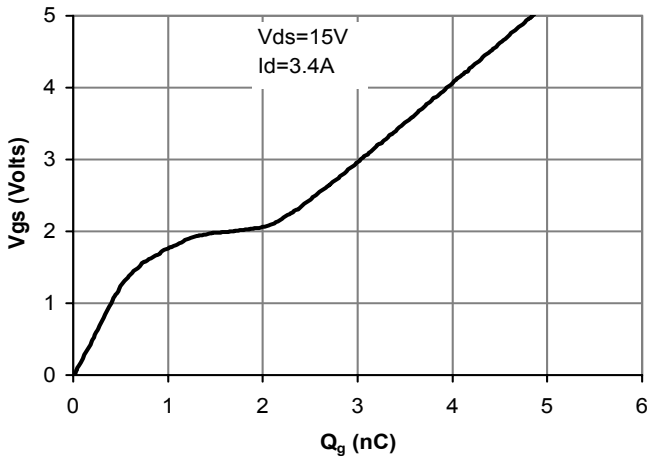


Figure 7: Gate-Charge Characteristics

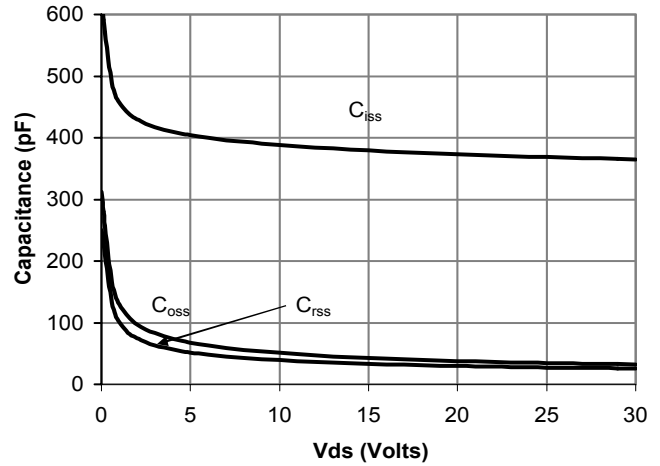


Figure 8: Capacitance Characteristics

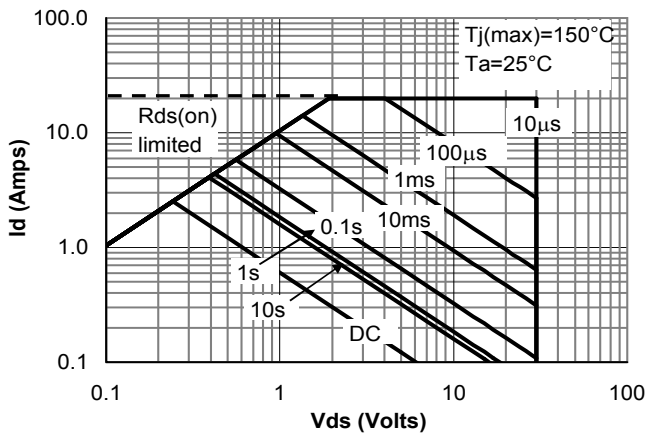


Figure 9: Maximum Forward Biased Safe Operating Area (Note 5)

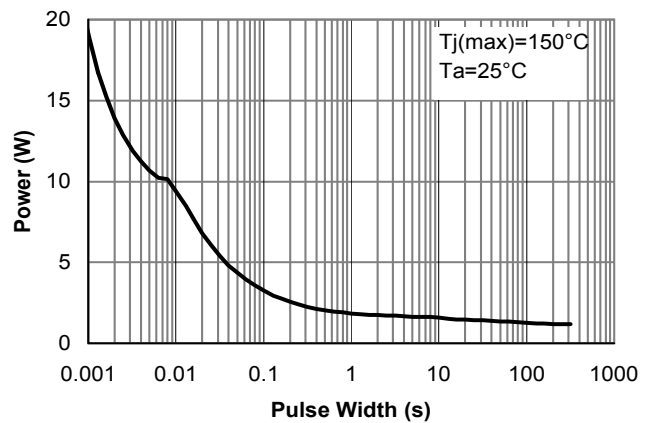


Figure 10: Single Pulse Power Rating Junction-to-Ambient (Note 5)

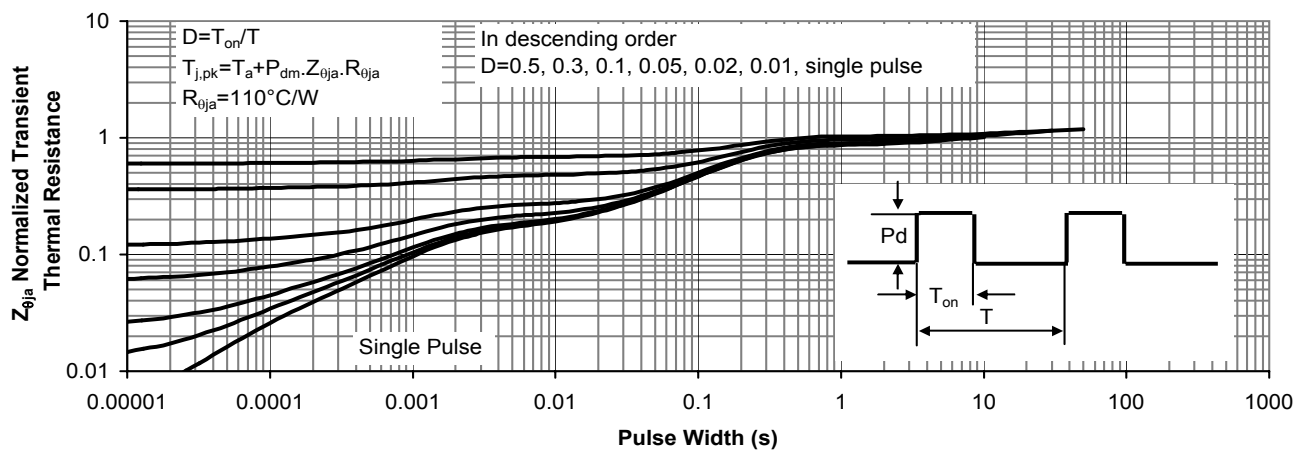


Figure 11: Normalized Maximum Transient Thermal Impedance